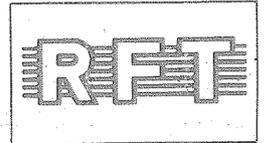


Information



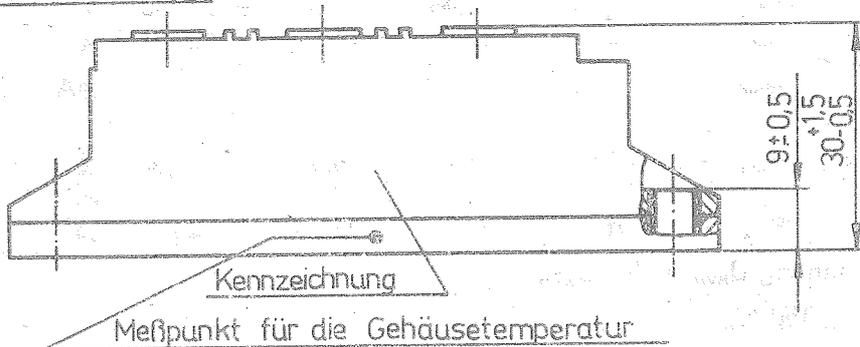
MDD 16, MDD 25, MDD 40, MDD 63

2/86

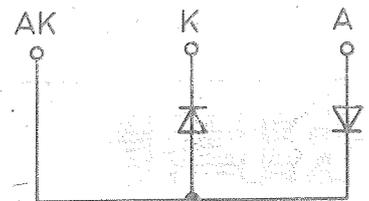
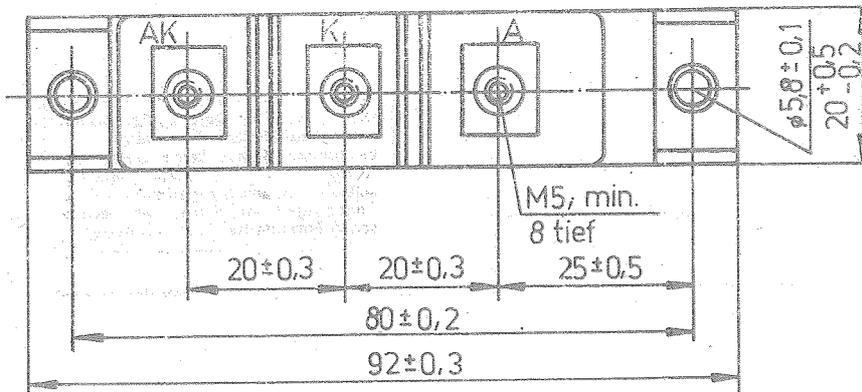
vorläufige technische Daten

Hersteller: VEB Mikroelektronik „Karl Liebknecht“ Stahnsdorf

Diodenmodule



Maße in mm
Masse etwa 200 g



Grenzwerte, gültig für den Sperrschichttemperaturbereich

	Periodische ¹⁾³⁾ Spitzensperrspannung	Nichtperiodische ²⁾ Spitzensperrspannung	Sperrgleich- spannung
	U_{RRM}/V	U_{RSM}/V	R_R/V
MDD 16, MDD 25	/ 1	100	70
MDD 40, MDD 63	/ 2	200	140
	/ 4	400	280
	/ 6	600	420
	/ 8	800	560
	/10	1 000	700
	/12	1 200	840
	/14	1 400	980
	/16	1 600	1 120

		MDD 16	MDD 25	MDD 40	MDD 63	
Mittlerer Durchlaßstrom Sinushalbwellen 3) $t_c = 100^\circ C$	$I_{F(AV)}$	16	25	40	63	A
Effektiver Durchlaßstrom bei 3)	$I_{F(RMS)}$	25	40	63	100	A
Stoßstrom $t_j = 150^\circ C$, $f = 50$ Hz-Sinushalbwelle	I_{FSM}	400	500	800	1 200	A

Kennwerte

Durchlaßspannung $t_c = 25^\circ C \pm 10$ K bei	U_F	$\leq 1,55$	$\leq 1,49$	$\leq 1,42$	$\leq 1,40$	V
Periodischer Spitzensperrstrom U_{RRM} , $t_j = 150^\circ C - 5$ K	I_{RRM}		≤ 5			mA
Innerer Wärmewiderstand	R_{thjc}	1,6	1,4	0,9	0,6	$\frac{K}{W}$
je Diode bei	$P_{F(AV)}$	10	20	20	40	W
Empfohlene Betriebsscheitelsperrspannung	$U_{RVM} = 0,7 U_{RRM}$					
Maximale Sperrschichttemperatur	$t_j = 150^\circ C$					

1) $\frac{t_p}{T} \leq 0,5$

2) $t_p \leq 20$ ms

3) $f = 40$ bis 60 Hz

Änderungen vorbehalten!

Die vorliegenden Datenblätter dienen ausschließlich der Information! Es können daraus keine Liefermöglichkeiten oder Produktionsverbindlichkeiten abgeleitet werden. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts sind vorbehalten.



Herausgeber

vob applikationszentrum elektronik berlin
im vob kombinat mikroelektronik

Mainzer Straße 25
Berlin 1035

Telefon: 5 80 05 21, Telex: 011 2981; 011 3055